

Índice general

1. Estado del Arte	1
1.1. Ortoferritas de Tierras Raras	1
1.2. Electromagnetismo en Sólidos	1
1.2.1. Magnetización y Polarización en Sólidos	2
1.2.2. Histéresis	2
1.2.3. Clasificación de Materiales	3
1.2.4. Multiferroicidad	4
2. Metodología	5
2.1. Síntesis	5
2.1.1. Sonicación	6
2.2. Caracterización	7
2.2.1. Análisis Termogravimétrico (TGA)	7
2.2.2. Difracción de Rayos X (DRX)	8
2.2.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)	12
2.2.4. Espectroscopía UV-Vis	16
2.2.5. Magnetometría	18
3. Resultados	21
3.1. Muestras Sintetizadas	21
3.2. Caracterización	22
3.2.1. Análisis Térmico	22
3.2.2. Análisis Estructural, Morfológico y de Composición	22
3.2.3. Análisis Óptico, Magnético y Eléctrico	24
Bibliografía	25

1 Estado del Arte

1.1. Ortoferritas de Tierras Raras

Los óxidos de tipo perovskita (ABO_3 con A una tierra rara o metal alcalinotérreo y B un metal de transición) son estructuras estudiadas muy comúnmente en el campo de la ciencia de materiales debido a sus propiedades electromagnéticas, ópticas y catalíticas, además de su estabilidad [1].

El objeto de estudio de este trabajo son las ortoferritas RFeO_3 , con R una tierra rara, específicamente $\text{R} = \text{Nd}, \text{Sm}$, debido a que presentan un orden magnético intrínseco proveniente de su estructura cristalina. Esta misma estructura además hace posible la presencia de ferroelectricidad, lo cual daría como resultado un material multiferroico [2].

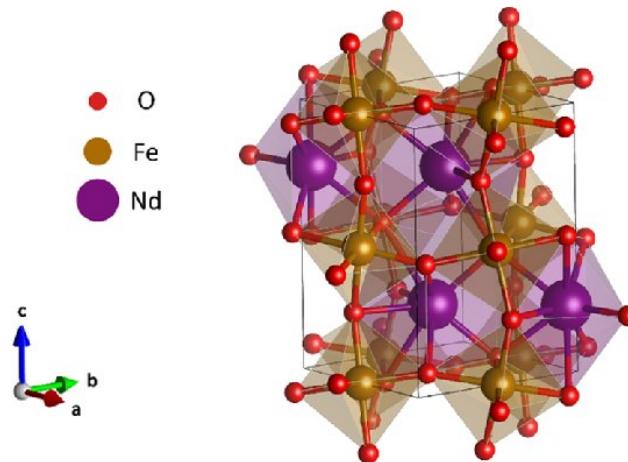


Figura 1.1: Estructura cristalina del NdFeO_3 . Tomado de [3]

1.2. Electromagnetismo en Sólidos

La respuesta de un sólido al aplicar un campo externo, sea éste magnético o eléctrico, depende de las propiedades intrínsecas de la estructura cristalina de éste. A pesar de esto, las interacciones a nivel cuántico se manifiestan macroscópicamente como propiedades extensivas, las cuales pueden estudiarse mediante la electrodinámica clásica.

Las ecuaciones de Maxwell pueden modificarse para incluir las contribuciones dependientes de las propiedades del material, considerando que las cargas y corrientes dentro de un éste pueden moverse libremente, o estar ligadas.

Así, se puede escribir:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \varepsilon_0 \vec{D} - \vec{P} \\ \vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} - \vec{M})\end{aligned}\quad (1.1)$$

Donde la fuente de los campos \vec{D} y \vec{H} son las cargas (o corrientes) libres, determinadas por la configuración del sistema, mientras que para los campos \vec{P} y \vec{M} son las cargas (o corrientes) ligadas, determinadas por las propiedades del material [4].

1.2.1. Magnetización y Polarización en Sólidos

Ambas propiedades representan la respuesta de la estructura a los campos externos. Macroscópicamente, pueden escribirse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}P_i &= \varepsilon_0 \chi_{ij}^{(e)} E_j \\ M_i &= \chi_{ij}^{(m)} B_j\end{aligned}\quad (1.2)$$

En esta expresión, χ_{ij} , la susceptibilidad, representa los componentes de un tensor de 3×3 [5].

Sin embargo, para un material isótropo, esta relación se simplifica a una multiplicación por un escalar, el cual aún puede depender de factores como la temperatura o el tiempo.

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \varepsilon_0 \chi^{(e)} \vec{E} \\ \vec{M} &= \chi^{(m)} \vec{B}\end{aligned}\quad (1.3)$$

Por otro lado, también es posible entenderlas como la suma de una propiedad microscópica, es decir, para un volumen de material V pueden escribirse como:

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \sum_i \frac{\vec{d}_i}{V} \\ \vec{M} &= \sum_i \frac{\vec{m}_i}{V}\end{aligned}\quad (1.4)$$

Donde \vec{m}_i es el momento magnético de cada electrón en el material, y \vec{d}_i es el momento dipolar de cada celda unitaria [6].

1.2.2. Histéresis

Un fenómeno presenta histéresis si depende no sólo de las condiciones actuales del sistema, sino que también de las condiciones anteriores. Ésto ocurre para propiedades como la elasticidad, la fricción, la superconductividad, la adsorción, la desorción y, siendo éstas el objeto de estudio de este trabajo, la magnetización y la polarización.

En general, la histéresis, observada en propiedades extensivas, proviene de las contribuciones microscópicas de propiedades intensivas [6].

Este fenómeno es evidente al aplicar un campo externo, sea este magnético o eléctrico, los dominios en el material cuya propiedad intensiva relevante sea paralela al campo aplicado

serán energéticamente favorables y por lo tanto crecerán a costa de aquellos dominios orientados de forma distinta, lo que aumenta la propiedad extensiva relevante hasta alcanzar un valor máximo, conocido como campo de saturación.

Este proceso no es reversible, si se quita el campo externo el sistema no regresará por si solo a la configuración inicial, sino que tendrá una polarización, o magnetización, remanente distinta de 0. Si se busca que ésta se anule, se debe de aplicar un campo externo en sentido opuesto, conocido como campo coercitivo.

1.2.3. Clasificación de Materiales

Es posible clasificar los materiales según su respuesta a los campos externos aplicados.

Hasta ahora ambos campos han tenido relaciones análogas, sin embargo, el hecho de que sólo el campo eléctrico posea cargas, hace que existan comportamientos de la polarización que no se observan para la magnetización. Por esta razón, se discutirán por separado.

1.2.3.1. Clasificación de Materiales Magnéticos

Pueden dividirse en dos grupos, aquellos cuyo comportamiento depende únicamente de las propiedades de los electrones en la red, y aquellos que dependen de un orden intrínseco en la red. El primer grupo se compone de los siguientes materiales:

- **Diamagnéticos:** Para un electrón sujeto a una órbita al cual se le aplica un campo magnético externo, la torca que éste ejerce sobre el momento magnético del electrón provoca un efecto conocido como la Precesión de Larmor, el cual consiste en una rotación periódica en el momento magnético. Ésto puede verse como una corriente que, debido a la Ley de Lens, provocará un campo magnético que se opone al campo que la generó, es decir, $\chi < 0$ [7].
- **Paramagnetismo:** Cuando un material que posee un electrón desapareado en su capa de valencia es expuesto a un campo magnético externo, favorecerá el alineamiento de los momentos magnéticos de cada electrón en el mismo eje. En particular, para los electrones desapareados, el campo favorecerá a la población paralela sobre la antiparalela, provocando una magnetización en el mismo sentido que el campo externo, es decir, $\chi > 0$, siendo χ constante a campos pequeños, pero llegando a una saturación cuando todos los momentos se han alineado. Sin embargo, al retirar el campo externo, estos momentos magnéticos volverán a orientarse de forma aleatoria, regresando la magnetización a 0 [7].

Por otro lado, en el segundo grupo se pueden identificar tres tipos de material:

- **Ferromagnéticos:** Debido a las propiedades de su estructura cristalina, estos materiales están divididos en zonas en las que el momento magnético tiene una dirección preferencial, llamados dominios magnéticos, los cuales se vuelven energéticamente más favorables al aplicar un campo magnético paralelo en el material, por lo que comienzan a crecer a costa de las zonas en direcciones distintas, es decir, presentan histéresis. Son similares a los materiales paramagnéticos debido a que ambos provienen de una reorientación de espines, ambos tienen una $\chi > 0$, y ambos poseen un campo de saturación M_s , sin embargo, como se discutió en la sección 1.2.2, al presentar histéresis estos también poseen magnetización remanente M_r , la cual se cancela con un campo coercitivo H_c [7].

- **Antiferromagnéticos:** De manera similar a los materiales ferromagnéticos, estos también presentan dominios magnéticos, y por tanto histéresis, sin embargo, estos dominios poseen no solo electrones apuntando con un momento magnético en una dirección, sino también electrones cuyo momento magnético apunta en dirección opuesta, ambos de igual magnitud, por lo que $M = 0$ [7].
- **Ferrimagnéticos:** Finalmente, los materiales ferrimagnéticos son similares a los antiferromagnéticos, también poseen dominios con electrones cuyos momentos magnéticos apuntan en direcciones opuestas, sin embargo los momentos en una dirección son más pequeños que los momentos en la otra, lo cual provoca una magnetización positiva, aunque menor a la de los materiales ferrimagnéticos [7].

1.2.3.2. Clasificación de Materiales Eléctricos

1.2.4. Multiferroicidad

2 Metodología

En este capítulo se describe el proceso de síntesis de ambas ortoferritas, así como las técnicas de caracterización utilizadas y las herramientas utilizadas para tratar los datos obtenidos a partir de éstas.

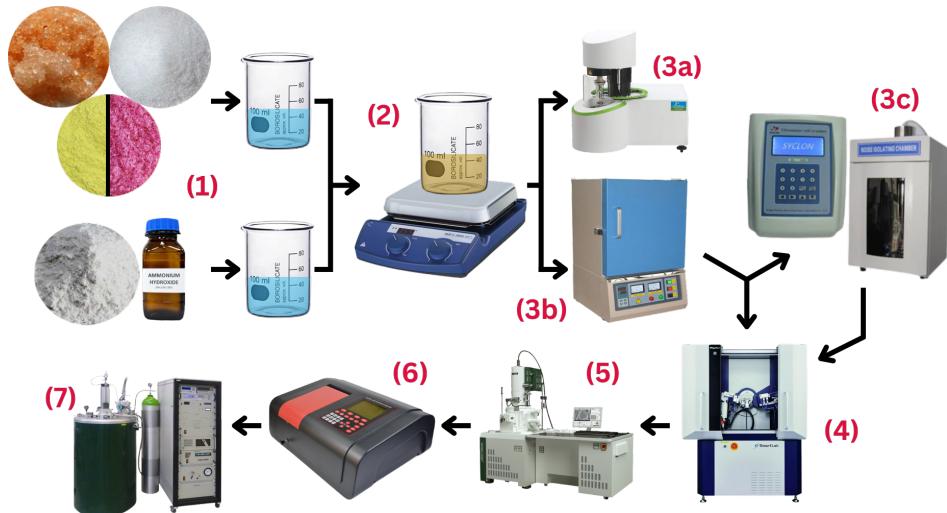
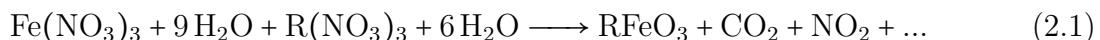


Figura 2.1: Diagrama de flujo del proceso de síntesis y caracterización seguido.

2.1. Síntesis

En el caso del NdFeO₃ se utilizaron los reactivos Fe(NO₃)₃·9H₂O (Nitrato de Hierro (III)) (Meyer, 98 %), Nd(NO₃)₃·6H₂O (Nitrato de Neodimio (III)) (Sigma-Aldrich, 99.9 %), C₆H₈O₇ (ácido cítrico) (Meyer, 99.5 %) y C₁₀H₁₆N₂O₈ (EDTA) (Meyer, 99.4 %), además de NH₄OH (Hidróxido de Amonio) (J. T. Baker 28.0-30.0 %), que se utiliza para disolver el EDTA en agua desionizada, además de neutralizar el pH de la mezcla. Por otro lado, para la síntesis del SmFeO₃ se utilizaron los mismos reactivos a excepción del Nd(NO₃)₃·6H₂O, el cuál fue sustituido por Sm(NO₃)₃·6H₂O (Nitrato de Samario (III)) (Sigma-Aldrich, 99.999 %). Esto con el fin de obtener la siguiente reacción:



Donde R=Nd, Sm.

Mediante una relación estequiométrica, se obtuvieron las cantidades que se muestran en la Tabla 2.1 por cada gramo de NdFeO₃ sintetizado:

Compuesto	Masa
Fe(NO ₃) ₃	1.628g
Nd(NO ₃) ₃	1.7665g
C ₆ H ₈ O ₇	0.774g
C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	1.1775g

Tabla 2.1: Cantidad de cada compuesto necesaria para sintetizar 1g de NdFeO₃.

Por su parte, la relación estequiométrica por cada gramo de SmFeO₃ es la que se muestra en la Tabla 2.2:

Compuesto	Masa
Fe(NO ₃) ₃	1.5875g
Sm(NO ₃) ₃	1.7465g
C ₆ H ₈ O ₇	0.755g
C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	1.1485g

Tabla 2.2: Cantidad de cada compuesto necesaria para sintetizar 1g de SmFeO₃.

En cada caso, los reactivos se mezclaron en dos vasos de precipitados con 20ml de agua desionizada cada uno, el EDTA y el hidróxido de amonio en un vaso y el resto de los compuestos en otro, como se observa en la figura 2.1 (1), se calentó el vaso que contenía EDTA a alrededor de 60°C mientras éste se disolvía y posteriormente se añadió el contenido del otro vaso de precipitados. Una vez hecho ésto, se comprobó que se tuviera un pH neutro y se subió la temperatura gradualmente hasta que la mezcla alcanzó alrededor de 80°C, lo cual se ilustra en la figura 2.1 (2), ésto con el fin de que se combustionara. Finalmente, el producto de esta combustión se molió haciendo uso de un mortero.

Se separó una muestra por cada tierra rara para realizar un análisis termogravimétrico, mostrado en la figura 2.1 (3a), del cual se hablará en una sección posterior.

El resto de muestras se calcinó por 12 horas, indicado en la figura 2.1 (3b) haciendo uso de un horno BR-12N-3 de la marca Brother Furnace, con una rampa de calentamiento de 10°C/min al subir la temperatura y 720 minutos constante en la temperatura objetivo. En cada muestra se utilizó una temperatura de calcinación distinta, ésta fue variada con intervalos de 100°C entre cada muestra, empezando en 500°C (600°C en el caso del SmFeO₃) y terminando en 1000°C.

2.1.1. Sonicación

Además de esto, se sintetizaron dos muestras adicionales de NdFeO₃ calcinadas a 600°C y SmFeO₃ calcinadas a 700°C, a éstas se les sometió a un proceso de sonicación a 292W con una punta ultrasónica modelo UH-650W de la marca HNZXIB Lab, una por 2h y otra por 4h, lo cual se muestra en la figura 2.1 (3c).

Esta técnica funciona a través de un generador electrónico que transforma una entrada de corriente alterna a una señal de 20kHz, la cual controla un convertidor piezoelectrónico para generar vibraciones mecánicas de alta frecuencia, las cuales son transmitidas a una punta ultrasónica la cual se sumerge en una solución que consiste en la muestra a sonicar y agua destilada. Las vibraciones de la punta generan burbujas microscópicas, en un fenómeno

conocido como cavitación. Éstas, al colapsar, liberan una gran cantidad de energía, la cual es suficiente para romper las partículas en suspensión [8].

La potencia de sonicación está limitada por la punta utilizada, en este caso el fabricante indica que el máximo para la punta utilizada es el 45 % de la potencia máxima del equipo, lo que equivale a 292W [9].

2.2. Caracterización

2.2.1. Análisis Termogravimétrico (TGA)

Esta técnica de caracterización, cuyo equipo se observa en la figura 2.1 (3a), y un diagrama de su estructura en la figura 2.2, consiste en pesar continuamente una muestra mientras se calienta, la cuál se encuentra en una atmósfera de gas inerte. Muchos sólidos experimentan reacciones que producen subproductos gaseosos, estos subproductos gaseosos se eliminan y se registran los cambios en la masa restante de la muestra. Mediante éste es posible encontrar la temperatura a la que ocurren distintas transformaciones en la sustancia, sean estas reacciones químicas, o cambios físicos, como la cristalización.

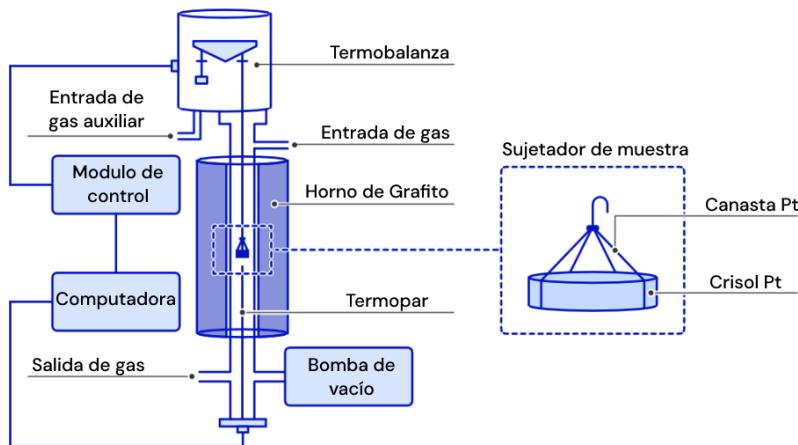


Figura 2.2: Diagrama de las partes que componen al equipo necesario para realizar un TGA. Adaptado de [10].

Los procesos que se observan mediante esta técnica pueden ser endo o exotérmicos, debido a que tienen un efecto en el cambio de temperatura del material, sin embargo, dado que esta técnica no mide directamente la energía térmica de la muestra, no es posible diferenciar entre estos procesos sólo con los datos obtenidos mediante esta técnica [11].

Sin embargo, es posible inferir información sobre la posible temperatura a la que ocurre la cristalización al comparar los datos obtenidos con la temperatura de los cambios que se espera ocurran en la muestra. En este caso, se espera que haya una combustión de la fase orgánica y la evaporación del agua contenida en la muestra entre los 100 y 200°C, mientras que la fase metálica es estable hasta temperaturas mucho más altas que las máximas alcanzadas por el equipo ($\approx 1000^{\circ}\text{C}$), por lo que es posible asociar un proceso que ocurra a una temperatura mayor a 200°C a la cristalización.

Se utilizó un *detector*, el cual se configuró con una rampa de calor de 10°C/min que fue de 30°C hasta 845°C.

2.2.2. Difracción de Rayos X (DRX)

Esta técnica, cuyo equipo se puede observar en la figura 2.1 (4) se basa en la interferencia constructiva que ocurre al irradiar una muestra cristalina con un haz de rayos X monocromados en ángulos que dependen de las fases que contenga la muestra. Funciona a través de un tubo de rayos catódicos que bombardea con electrones a un objetivo, los cuales, al tener la energía suficiente, desplazarán los electrones más internos de los átomos del objetivo a niveles energéticos más altos, los cuales a su vez, al regresar al estado de menor energía liberan rayos X de una longitud de onda característica que depende del material objetivo utilizado, los cuales irradian la muestra que se quiere medir en un arreglo como el que se ilustra en la figura 2.3, lo cual brinda información sobre las fases contenidas en la muestra, como se explicará en las siguientes secciones [12].

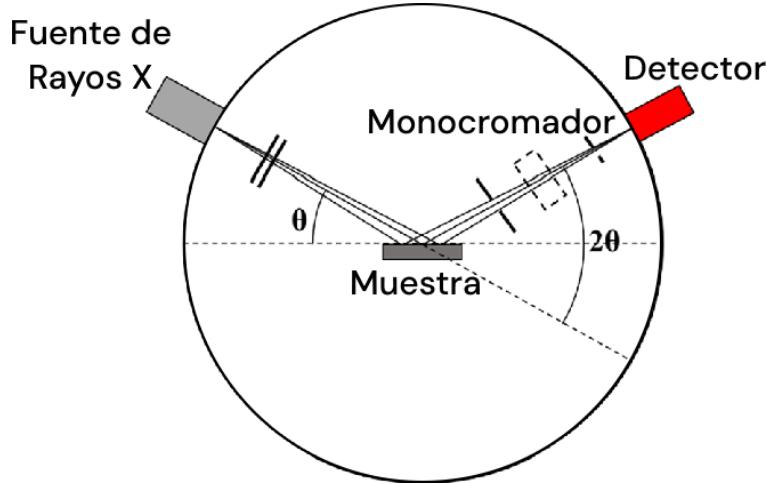


Figura 2.3: Arreglo experimental utilizado para la obtención de espectros de difracción de rayos X. Adaptado de [13]

Se utilizó un *detector* para las muestras en polvo, y un difractómetro *Rigaku Ultima IV* para las muestras sinterizadas, ambos con fuentes de Cobre ($K_{\alpha} = 1.54\text{\AA}$), la medición se realizó con $2\theta \in (20^\circ, 80^\circ)$.

2.2.2.1. Estructura Cristalina

Los átomos y moléculas que conforman la mayoría de sólidos, como el cuarzo, la sal, los metales o los óxidos, se encuentran en un arreglo periódico regular, ésto se conoce como cristalinidad, y a la estructura periódica como estructura cristalina.

Pensando en cada átomo pertenecientes a un cristal como un punto, podemos expresar un cristal en 3 dimensiones como el conjunto de puntos que cumplen:

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^3 n_i \mathbf{a}_i \quad (2.2)$$

Donde \mathbf{a}_i son vectores no colineales que representan cada dirección del cristal, cuyo tamaño es la separación entre átomos en esa dirección, además, $0 \leq n_i < N_i$ es un número entero, donde N_i es el tamaño máximo del cristal en esa dirección.

La estructura que forma esta construcción, incluyendo los ángulos entre cada vector \mathbf{a}_i , se conoce como red de Bravais. Existen sólo 14 posibles redes, como se puede ver en la figura 2.4 las cuales pueden definirse a través de su celda unitaria, que representa la unidad mínima del cristal que, al repetirse periódicamente en todas direcciones, genera el cristal entero [14].

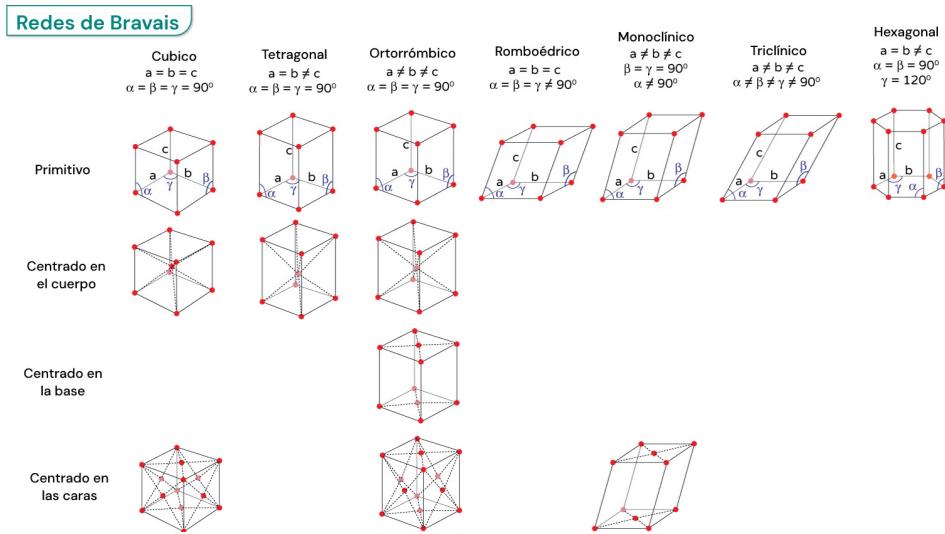


Figura 2.4: Redes de Bravais. Adaptado de [15].

Es posible expresar la orientación de cualquier plano que corte la estructura cristalina a través de los índices de Miller, éstos se obtienen a partir de las distancias entre el origen y los puntos en los que el plano intersecta a los ejes, expresado como fracciones de la distancia entre átomos en ese eje. Si se tomaran directamente estas distancias, no se podría tratar directamente con planos perpendiculares a los generados por los ejes, debido a que la intersección entre estos ocurre en el ∞ , por esta razón, los índices de Miller se definen a través del recíproco de estas distancias, tomando 0 como recíproco de ∞ , dando como resultado 3 números h, k, l , que se expresan como (hkl) , si alguno fuese negativo se escribe con una barra encima, $(\bar{h}kl)$. Finalmente, los 3 números obtenidos se multiplican por una constante para obtener el conjunto de enteros más pequeños generable con la menor cantidad de números negativos para ese trío de números [16].

2.2.2.1.1 Ley de Bragg

Si se tienen dos ondas que inicialmente están en fase, y se hace que una de éstas tome un camino más largo que la otra, para posteriormente reunirlas, éstas tendrán ahora una diferencia de fase igual a la diferencia en longitud de ambos caminos. Ésto es relevante para la derivación de la ley de Bragg debido a la estructura periódica del cristal, debido a la forma en la que éstos difractan rayos X.

La figura 2.5 muestra la sección de un cristal, cuyos átomos se encuentran ordenados en los planos paralelos A, B, \dots , los cuales están separados por una distancia d' . A éste cristal se le irradia con una fuente de rayos X monocromática de longitud de onda λ en un ángulo θ . Considerando dos rayos cualesquiera que golpeen al cristal, éstos al ser dispersados estarán

en fase, y por lo tanto interferirán sólo de manera constructiva, si y sólo si la diferencia entre la longitud de sus caminos es de $n\lambda$, lo cuál se conoce como difracción.

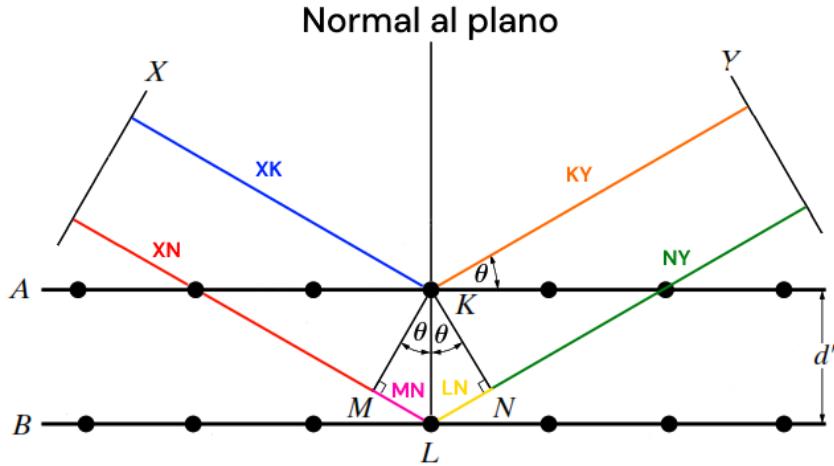


Figura 2.5: Difracción de rayos X por un cristal. Adaptado de [16].

En la figura 2.5, la recta X representa el emisor de fotones, mientras que la recta Y el detector de éstos.

Se tienen en esta figura dos rayos, uno compuesto por los segmentos \overline{XK} (azul) y \overline{KY} (naranja), y otro compuesto por los segmentos \overline{XN} (rojo), \overline{MN} (rosa), \overline{LN} (amarillo) y \overline{NY} (verde), como se muestra en la figura 2.5.

Tomando en cuenta que los segmentos \overline{XK} y \overline{XN} son iguales, lo cual también ocurre para los segmentos \overline{NY} y \overline{KY} , la diferencia en la distancia recorrida por ambos rayos se puede expresar como:

$$\begin{aligned} (\overline{XM} + \overline{ML} + \overline{LN} + \overline{NY}) - (\overline{XK} + \overline{KY}) &= (\overline{XK} + \overline{ML} + \overline{LN} + \overline{KY}) + (\overline{XK} + \overline{KY}) \\ &= \overline{ML} + \overline{LN} = 2d' \sin \theta \end{aligned} \quad (2.3)$$

Es decir, éstos forman un rayo difractado si y sólo si:

$$n\lambda = 2d' \sin \theta \quad (2.4)$$

Esta ecuación se denomina ley de Bragg [16].

2.2.2.2. Refinamiento Rietveld

El método de Rietveld es una técnica de refinamiento que permite estudiar los patrones de difracción generados por rayos X de manera cuantitativa. Esta técnica permite encontrar información sobre la composición de la muestra, las fases cristalinas existentes en ésta y la posible presencia de contaminantes que posean una fase cristalina.

Consiste en utilizar el método de mínimos cuadrados para ajustar un modelo teórico a un patrón experimental de rayos X. Para este modelo se deben tomar en cuenta factores tales como aspectos estructurales (geometría de la celda unitaria, posiciones atómicas, vibraciones térmicas), microestructurales (mezcla de fases, concentración, deformaciones) e instrumentales (anchura de las rejillas utilizadas, tamaño de la muestra irradiada) [17]. La función a minimizar se define entonces como

$$S_y = \sum_i W_i (y_i - y_{i,c})^2 \quad (2.5)$$

Donde y_i , $y_{i,c}$ son las intensidades observadas y calculadas respectivamente y W_i es el peso dado a cada una de éstas, usualmente $1/y_i$ [18].

Por su parte, es posible expresar $y_{i,c}$ de la siguiente forma [17]:

$$y_{i,c} = \sum_j y_{i,j} = \sum_j S_j \sum_k L_{k,j} F_{k,j}^2 \phi_{k,j} (2\theta_i - 2\theta_{k,j}) P_{k,j} A + y_{b,i} \quad (2.6)$$

Donde:

- $y_{i,c}$ es la intensidad calculada en el punto i del patrón de difracción.
- $y_{i,j}$ es la intensidad en el punto i del patrón de difracción debido a la fase j .
- S_j es el factor de escala correspondiente a la fase j .
- k representa al pico de difracción k -ésimo del patrón de difracción.
- $L_{k,j}$ representa los factores de Lorentz, polarización y factor de multiplicidad.
- $F_{k,j}^2$ es el factor de estructura de la fase j .
- $\phi_{k,j}(2\theta_i - 2\theta_{k,j})$ es la función que describe el pico de difracción centrado en el ángulo $2\theta_{k,j}$ de la fase j . Ésta puede ser gaussiana, lorentziana o una combinación lineal de ambas.
- $P_{k,j}$ es la función que describe la orientación preferencial cuando los cristales de la fase j no se encuentran en forma aleatoria.
- A es un factor de absorción que depende del espesor de la muestra y la geometría del equipo de difracción.
- $y_{b,i}$ es la intensidad del fondo en el punto $2\theta_i$ del patrón de difracción.

Para realizar éste análisis, se utilizó el programa *MAUD - Materials Analysis Using Diffraction* [19], el cual permite importar datos teóricos de cada una de las fases cristalinas, obtenidos de [20], para calcular las intensidades teóricas utilizadas en el método Rietveld y utilizar éstas en conjunto con los datos experimentales en el refinamiento para minimizar S_y (ecuación 2.6) a través de los parámetros descritos anteriormente. Ésto dando como resultado gráficas como la que se muestra en la figura 2.6, además del porcentaje que representa cada fase en la muestra y la calidad del ajuste a través de los criterios que se discutirán en la sección 2.2.2.1.

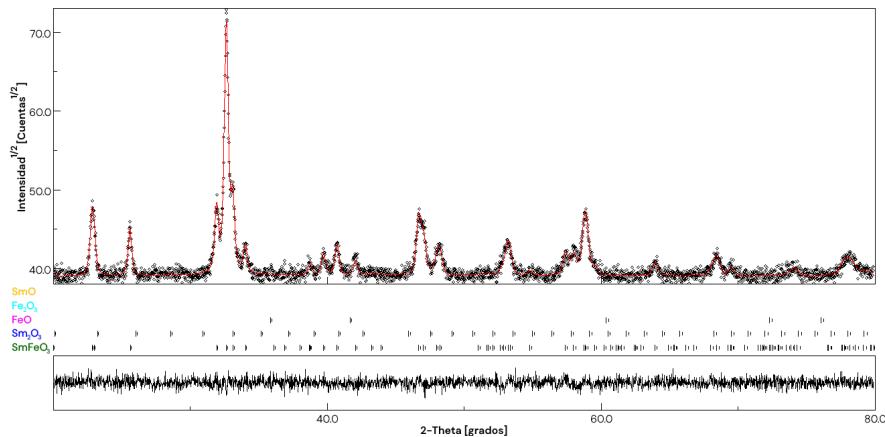


Figura 2.6: Modelado de picos de difracción utilizando *MAUD*.

2.2.2.2.1 Criterios de Refinamiento

Existen diversos criterios de refinamiento cuyo valor permite conocer la calidad de éste. Los que se utilizaron para evaluar los resultados obtenidos son [17]:

- a) Residuo del patrón pesado (R_{wp}): Éste muestra el progreso del refinamiento, debido a que en el numerador contiene la función que se está minimizando (ecuación 2.6). Se expresa de la siguiente manera:

$$R_{wp} = \left[\frac{\sum_i W_i (y_i - y_{i,c})^2}{\sum_i W_i y_i^2} \right]^{1/2} \quad (2.7)$$

- b) Valor esperado (R_{exp}): Refleja la calidad de los datos obtenidos en la medición del patrón de difracción. Se expresa de la siguiente manera:

$$R_{exp} = \left[\frac{N - P}{\sum_i W_i y_i^2} \right]^{1/2} \quad (2.8)$$

Donde N es el número de datos observados y P es el número de parámetros a refinar.

- c) Ajuste de bondad (χ^2): Éste permite comparar el tamaño de los errores estadísticos (R_{exp}) con los errores producto del proceso de refinamiento (R_{wp}). Para que se considere que este método produjo un ajuste correcto, se busca que este criterio tenga un valor entre 1 y 1.3. Se expresa de la siguiente manera:

$$\chi^2 = \frac{R_{wp}}{R_{exp}} \quad (2.9)$$

2.2.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

Los microscopios electrónicos de barrido, de los cuales se muestra un diagrama en la figura 2.7 y se ilustran en la figura 2.1 (5), permiten lograr amplificaciones mucho mayores que las de un microscopio óptico a través del uso de electrones para generar la imagen.

Estos funcionan haciendo uso de una fuente de electrones, los cuales son acelerados con un potencial de 30kV y posteriormente son focalizados haciendo uso de lentes magnéticos. Se utilizan comúnmente tres de éstos, dos condensadores y un objetivo, siendo éste un determinante en la calidad de la imagen. Ésto produce un haz de electrones con un diámetro de entre 1 y 10nm.

Se generan campos magnéticos utilizando bobinas conectadas a generadores de ondas de escalera de n y m pasos, éstos cambian la dirección del haz, permitiendo escanear con éste una superficie rectangular dividida en $n \cdot m$ pixeles [21].

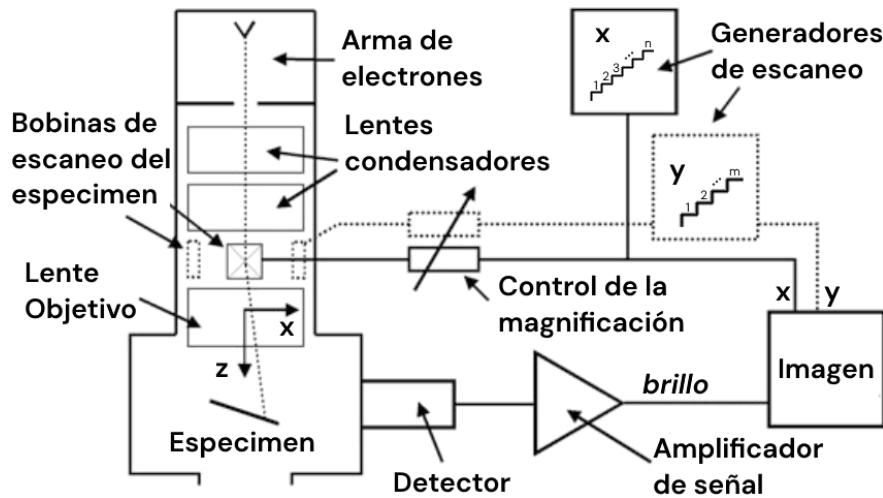


Figura 2.7: Diagrama de un microscopio electrónico de barrido. Adaptado de [21].

Se utilizó un microscopio *JEOL JSM-7800F Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope*, haciendo uso de un voltaje de 15kV, una corriente de 8 unidades arbitrarias y un vacío de $9.6 \cdot 10^{-5}$ Pa.

Las muestras fueron preparadas colocando cada una en un portamuestras de aluminio cubierto con cinta de carbono, éstos materiales se utilizan debido a que no son magnéticos pero sí conducen la electricidad.

Estos portamuestras fueron colocados en una platina, la cual fue ingresada a la cámara de vacío del microscopio, donde se realizó la medición.

2.2.3.1. Interacciones Electrón-Sólido

Los electrones utilizados en un microscopio electrónico de barrido se conocen como electrones primarios cuando forman parte del haz generado. Una vez que éste entra a un sólido, cada electrón puede interactuar con los átomos presentes de diversas formas. Sin embargo, solamente tres son de interés, debido a que el resto no es medible por el microscopio electrónico. Éstas interacciones son las siguientes [21]:

- **Electrones Retrodispersados:** Al darse una colisión elástica, producto de la interacción electrostática electrón primario-núcleo, los electrones del haz se ven dispersados. La mayoría de estas deflexiones tienen un ángulo menor a 90°, lo cual implica que el haz permanece en el sólido, sin embargo, también pueden darse con un ángulo mayor, conservando la mayor parte de su energía inicial, esto haciendo muy probable que los electrones salgan del sólido, como se puede ver en la figura 2.8a.

- **Electrones Secundarios:** En el caso de las colisiones inelásticas, producto de la interacción entre los electrones primarios y los electrones de valencia y conducción del sólido, cuando éstos colisionan, una pequeña parte de la energía se usa como energía potencial permitiendo al electrón salir de su orbital, conservando el resto de la energía perdida por el electrón primario como energía cinética. Aún así, la energía de los electrones producidos por este tipo de interacción es mucho menor a la anterior, permitiendo que escapen del sólido sólo aquellos más cercanos a la superficie. Ésto se ilustra en la figura 2.8b.
- **Rayos X Característicos:** En éste caso, la colisión inelástica ocurre entre el electrón primario y un electrón de una capa interna del átomo, lo cual hace que éste pase brevemente a un estado de energía más alto y rápidamente decaiga de nuevo, liberando un fotón en el proceso. Este fotón estará en el rango de frecuencias de los rayos X, dependiendo el valor exacto de ésta solamente del número atómico Z del átomo, permitiendo conocer la composición química de la muestra. A ésta técnica se le conoce como Espectroscopía de Dispersión de Energía (EDS por sus siglas en inglés). Un ejemplo de esta interacción se muestra en la figura 2.8c.

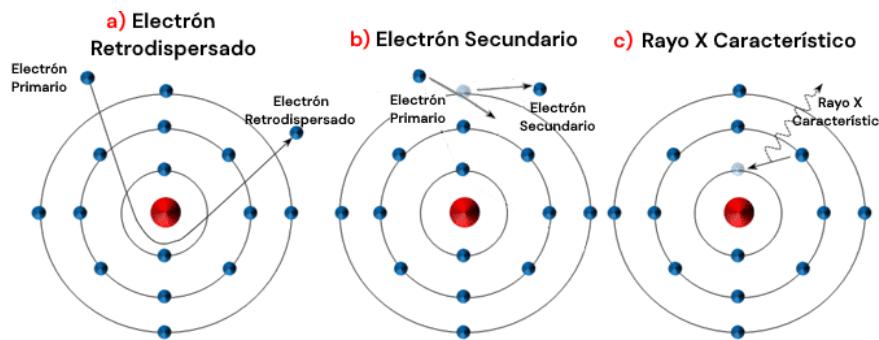


Figura 2.8: Tipos de interacciones electrón-sólido en un microscopio electrónico de barrido. Adaptado de [22].

En el caso de los EDS realizados, se utilizaron las mismas condiciones que en la obtención de imágenes, es decir, voltaje de 15kV, corriente en 8 unidades arbitrarias, presión de $9.6 \cdot 10^{-5}$ Pa. Se registraron los rayos X emitidos por la muestra durante un minuto en cada medición.

2.2.3.2. Análisis Estadístico del Tamaño de Partículas

Las imágenes obtenidas a través de SEM fueron analizadas a través de ImageJ [23], éstas fueron procesadas definiendo la escala correcta en μm , en éste caso se tomaron las imágenes obtenidas en una amplificación de x500 debido a que éstas muestran de manera completa las partículas grandes mientras siguen siendo visibles las más pequeñas, como se puede ver en la figura 2.9a. Se prosiguió utilizando la función *Threshold* para definir la posición de las partículas en la imagen, como se observa en la figura 2.9b, seguido de la función *Analyze Particles* para seleccionarlas y medirlas, esto se puede ver en la figura 2.9c, lo cual dió como resultado una tabla que registra el diámetro de cada partícula detectada por el programa.

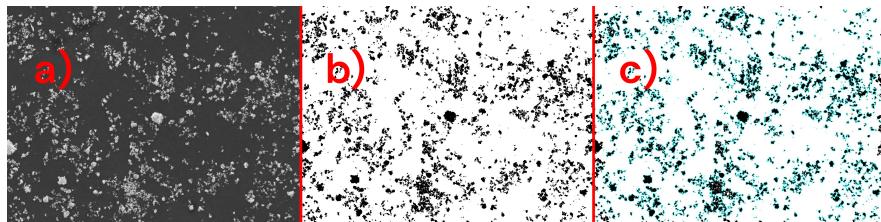


Figura 2.9: Procesado de Imágenes con ImageJ.

Para visualizar los datos obtenidos mediante este método, se empleó un histograma del diámetro de las partículas de cada muestra, como se observa en la figura 2.10.

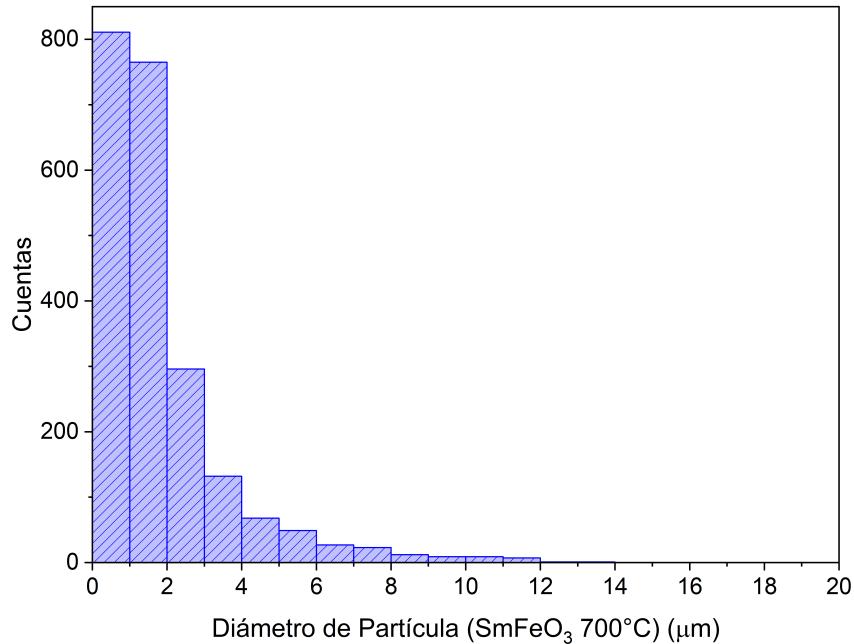


Figura 2.10: Histograma de los datos obtenidos con ImageJ.

Se obtuvo a partir de éste el porcentaje de partículas con un diámetro menor o igual a $1\mu\text{m}$. Éste se puede expresar de la siguiente manera:

$$P = \frac{n}{N} \cdot 100 = p \cdot 100 \quad (2.10)$$

Donde n es el número de partículas con diámetro $\leq 1\mu\text{m}$, N es el número total de partículas y $p = n/N$ es la proporción entre n y N .

Suponiendo que cada medición tiene una probabilidad constante a de estar en una determinada barra y que cada tamaño es independiente de los demás, la probabilidad A de observar exactamente n partículas de diámetro $\leq 1\mu\text{m}$ es de:

$$A(n) = \binom{N}{n} a^n (1-a)^{N-n} \quad (2.11)$$

Es decir, las barras siguen una distribución binomial, por lo que es posible utilizar la siguiente forma de la varianza [24]:

$$\text{Var}(n) = N \cdot p \cdot (1-p) \quad (2.12)$$

Cuyas variables son las mismas que las descritas en la ecuación 2.10. Finalmente, la raíz cuadrada de esta cantidad es la desviación estándar, la cual se expresa de la siguiente manera:

$$\sigma_n = \sqrt{\text{Var}(n)} = \sqrt{N \cdot p \cdot (1 - p)} \quad (2.13)$$

Debido a que se busca encontrar la desviación estándar del porcentaje y no del número de partículas, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} P &= \frac{100}{N} \cdot n \implies \sigma_P = \frac{100}{N} \cdot \sigma_n \\ \iff \sigma_P &= \frac{100}{N} \sqrt{N \cdot p \cdot (1 - p)} = \frac{100}{\sqrt{N}} \sqrt{p \cdot (1 - p)} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Se puede utilizar el doble de la desviación estándar para asignar un valor de incertidumbre a ésta medición, debido a que ésta especifica cuantitativamente la precisión de una medida, ésto debido a que, para distribuciones binomiales, se tiene cerca del 95.45 % de los valores en el intervalo $(\bar{X} - 2\sigma, \bar{X} + 2\sigma)$, teniendo éste porcentaje en el límite en el que la distribución es normal [25].

2.2.4. Espectroscopía UV-Vis

Esta técnica, cuyo equipo se puede observar en la figura 2.1 (6), mide la cantidad de luz UV o visible que es absorbida o transmitida a través de una muestra en comparación con una referencia o una muestra en blanco.

Cuando un fotón interactúa con la materia éste puede ser absorbido, lo cuál sólo ocurre si éste tiene la energía correcta para llevar un electrón de un estado a otro. Es por ésto que la absorción depende de la longitud de onda de la luz.

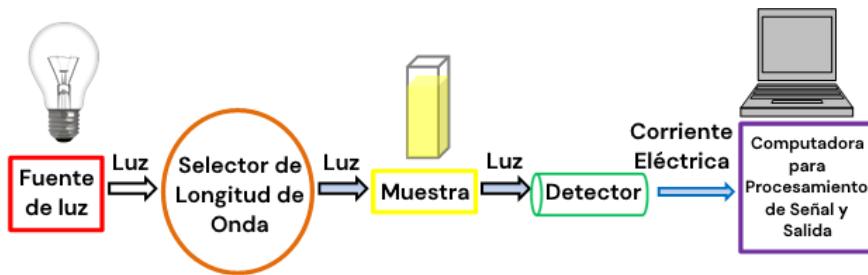


Figura 2.11: Diagrama de un espectrómetro UV-Vis. Adaptado de [26].

En la figura 2.11 se observa un diagrama simplificado del funcionamiento del equipo necesario para esta técnica. Comienza con una fuente de luz, comúnmente utilizándose dos lámparas, una de deuterio para la luz UV y una halógena para la luz visible. Ésto causa que el equipo cambie de lámpara alrededor de los 300-350nm, lo cual es necesario tomar en cuenta al analizar los datos.

Posteriormente, se hace pasar el haz de luz a través de monocromadores, además de filtros de absorción, de interferencia y de corte, ésto permite seleccionar un rango de frecuencias, el cual puede variarse y así analizar por separado las frecuencias que las lámparas emiten.

Después, el haz resultante se incide primero en una muestra en blanco para medir el fondo y restar éste de los datos que se obtengan, para luego incidir el haz sobre la muestra y registrar ya sea la absorbancia o reflectancia a través de detectores, los cuales funcionan

haciendo uso de semiconductores o una capa fotoeléctrica, debido a que ambos generan una corriente proporcional a la intensidad de la luz incidente [26].

En el caso de las mediciones realizadas, se utilizó un espectrómetro modelo *Macylab UV-1800CPC* en modo de absorción en precisión normal, utilizando luz de 200 a 800nm, con un paso de 0.2nm.

2.2.4.1. Método Tauc

Una de las propiedades ópticas más importantes en los semiconductores se conoce como brecha de energía prohibida o *band gap*. Esta nos habla de la separación entre el estado más energético ocupado por los electrones del material (banda de valencia) y el estado siguiente (banda de conducción), este concepto se ilustra en la figura 2.12. El *band gap* es la energía requerida para que un electrón pase de una banda a la otra [14].

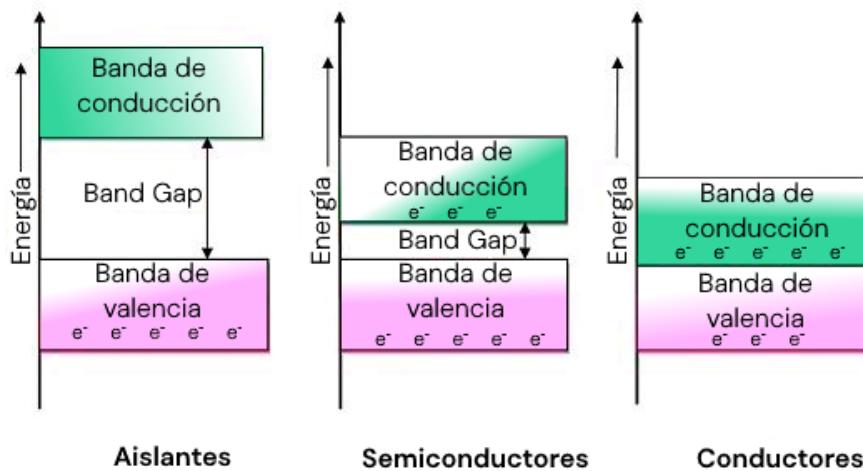


Figura 2.12: Diagrama del *band gap* de distintos tipos de materiales. Adaptado de [27].

Sin embargo, los datos obtenidos a través de la espectroscopía UV-Vis no proporcionan esta propiedad directamente, sino que es necesario analizar los resultados a través del método Tauc.

Éste permite obtener el *band gap* del material estudiado partiendo de suponer que la absorbancia (α) puede expresarse como:

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot h\nu)^{1/\gamma} &= B h\nu - E_g \\ \iff (\alpha \cdot E_\nu)^{1/\gamma} &= B E_\nu - E_g \end{aligned} \quad (2.15)$$

Donde h es la constante de Plank, ν es la frecuencia del fotón, B es una constante, $\gamma = 1/2, 2$ según se tenga un *band gap* directo o indirecto respectivamente, E_ν es la energía de un fotón de frecuencia ν y E_g es la energía del *band gap* [28].

El espectrómetro, al medir absorbancia, permite conocer α respecto a ν , por lo tanto basta con encontrar una zona de la gráfica de $(\alpha \cdot h\nu)^{1/\gamma}$ respecto a $h\nu$ que tenga un comportamiento lineal para así ajustar una recta por mínimos cuadrados y encontrar los valores que este ajuste arroje para E_g , como se puede observar en la figura 2.13.

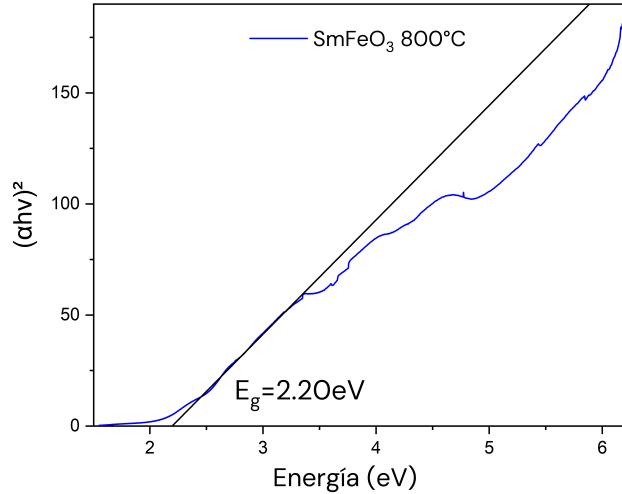


Figura 2.13: Aplicación del método Tauc para la muestra de SmFeO₃ calcinada a 800°C.

2.2.5. Magnetometría

2.2.5.1. Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica (SQUID)

2.2.5.1.1 *Zero Field Cooling* y *Field Cooling*

2.2.5.1.2 Mediciones Magnéticas Realizadas

Mediciones Ferroeléctricas

2.2.5.2. Preparación de la Muestra

Para conseguir medir la polarización contra la carga aplicada es necesario que la muestra sea un sólido. Para conseguir esto a partir de los polvos sintetizados se tuvo que realizar un proceso de molienda (sección 2.2.5.3) y sinterización (sección 2.2.5.4). Ésto se realizó con las ortoferritas calcinadas a temperatura más baja (600°C para el NdFeO₃ y 700°C para el SmFeO₃), tanto a las muestras sin procesar como a las sonicadas por 4 horas a 292W.

2.2.5.3. Molienda

La molienda se realizó haciendo uso de un molino de bolas vibratorio de alta velocidad modelo *HVBM-1200* de la marca *MicroNanoTools*, que tiene una velocidad de 1200rpm [29].

Los molinos de bolas, en su forma más simple, consisten de un cilindro hueco, el cual se llena con la muestra a moler, las bolas a utilizar y opcionalmente un solvente o lubricante para limitar el calor generado.

Éste se monta en un motor que lo hace rotar, lo cual genera colisiones entre las bolas, el material y las paredes debido a la fuerza centrífuga, lo cual tiene como resultado el molido del material, lo que se ilustra en la figura 2.14 [30].

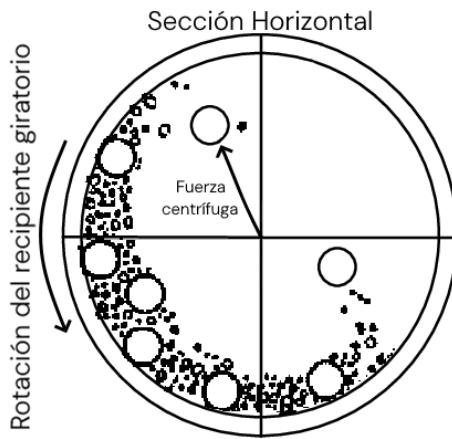


Figura 2.14: Diagrama de un molino de bolas. Adaptado de [30].

Se colocaron 0.6g de la muestra a moler dentro de un reactor de Circonio con bolas del mismo material, con un diámetro de alrededor de 1cm, además de 30ml de isopropanol. Posteriormente se montó el reactor en un soporte de acero inoxidable y finalmente se aseguró en el molino, el cual se hizo funcionar por 20 minutos para cada muestra.

2.2.5.4. Sinterización

La sinterización es un tratamiento térmico de polvos metálicos o cerámicos en objetos sólidos a través de procesos de transporte de masa a nivel atómico, haciendo uso de presión y temperatura, sin que esta última llegue a la temperatura de fusión del material [31].

Un sólido debe tener una energía mayor en su superficie que en el resto del material pues la fuerza que la mantiene unida es menor. Esta energía libre de superficie (G_s) se describe a través de la energía libre de Gibbs G y la tensión superficial γ en una superficie A de la siguiente manera:

$$\gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial A} \right)_{T,P,n} \quad G_s = \sum_{i=1}^m n_i \mu_i + \gamma A \quad (2.16)$$

Donde n_i es la cantidad de moles de la sustancia i -ésima y μ_i es su potencial químico. Debido a que, al aumentar la superficie, n_i es creciente para cualquier i , y debe ser estrictamente creciente para al menos una i , para alguna función $N(A)$ estrictamente creciente podemos escribir

$$\sum_{i=1}^m n_i \mu_i = N(A) G_s(A) = N(A) + \gamma A \quad (2.17)$$

Donde $G_s(A)$ es estrictamente creciente. Debido a que ambos términos que componen a G_s dependen de

Este proceso funciona a través de la difusión de los átomos en las fronteras entre granos, uniéndolos en el proceso, esto debido a la energía aplicada en forma de presión y calor, la cual provoca un reordenamiento de los cristales a una configuración de menor energía libre en su superficie, es decir, se eliminan las fronteras y las porosidades, como se muestra en la figura 2.15 [32].

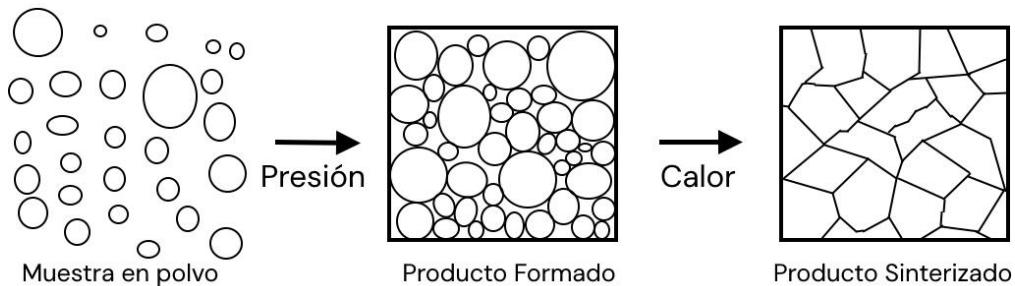


Figura 2.15: Diagrama del proceso de sinterización. Adaptado de [32].

Los resultados de este proceso dependen de la temperatura, presión aplicada, tiempo de sinterización e incluso de la presión atmosférica. En este trabajo se tomaron como condiciones de sinterización una presión de 5t aplicada por 15 minutos, realizado con una prensa hidráulica manual de 15t de marca *SPECAC*, y una temperatura de 1000°C aplicada por 2 horas, haciendo uso de un horno (*nombre*) [33].

2.2.5.5. Mediciones de Polarización

Es posible obtener la polarización debido a que la carga (Q) en la muestra puede expresarse como:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I(t)dt \quad (2.18)$$

Donde I es la corriente que se hace pasar a través de la muestra en el tiempo t .

Con esto, podemos expresar el desplazamiento dieléctrico (D) como:

$$D(t) = \frac{Q}{A} \quad (2.19)$$

Donde A es el área superficial de la muestra.

$$P(t) = D(t) - \epsilon_0 E(t) \quad (2.20)$$

Finalmente, debido a que E es una función de t cuyo valor se controla a través del dispositivo, es posible graficar $P(E)$, lo cual es la medición buscada [34].

3 Resultados

Para conseguir resultados significativos, no sólo debieron seguirse los métodos descritos en el capítulo anterior, sino que también estos se realizaron en un orden particular, que permitió determinar las condiciones de las técnicas subsecuentes además de prevenir mediciones innecesarias. En la figura 3.1 se puede observar un diagrama del orden seguido.

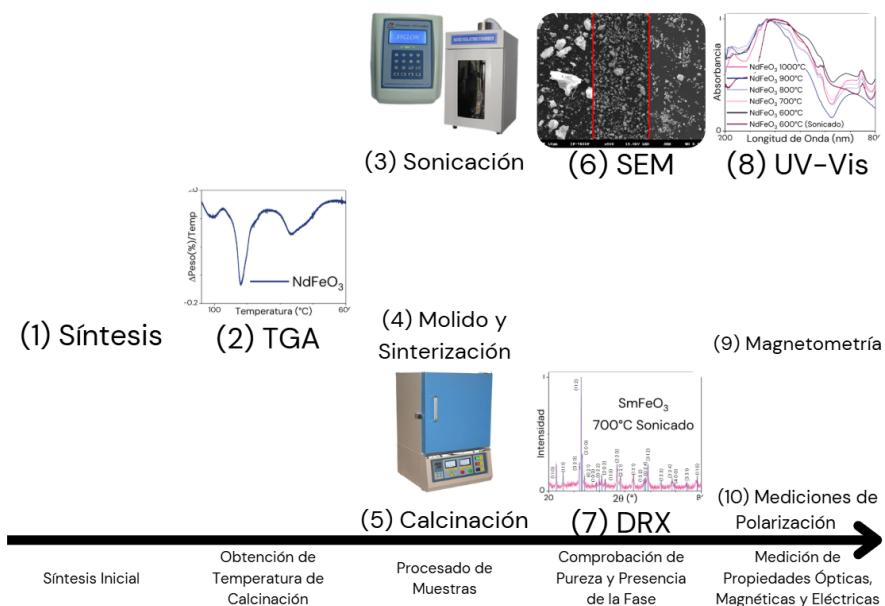


Figura 3.1: Resultados obtenidos mediante las técnicas de síntesis y caracterización descritas en el capítulo 4.

3.1. Muestras Sintetizadas

Se sintetizaron un total de 9 muestras de 1gr de NdFeO₃ y 8 de SmFeO₃. Una muestra de cada ortoferrita fue reservada para realizar un análisis termogravimétrico. A través de éste, se determinó la temperatura mínima de calcinación para ambas ortoferritas, como se reporta en la sección 3.2.1.1.

Con estas temperaturas en mente, 600°C para el NdFeO₃ y 700°C para el SmFeO₃, se calcinaron el resto de muestras, 4 muestras de NdFeO₃ se calcinaron a 600°C, para las otras 4 se aumentó la temperatura 100°C por cada una, es decir, se calcinaron a 700, 800, 900 y 1000°C respectivamente.

Por otro lado, para el SmFeO₃ se calcinaron 4 muestras a 700°C, aumentando la temperatura de la misma forma que en el caso del NdFeO₃ para las otras 3, es decir, se calcinaron

a 800, 900 y 1000°C respectivamente.

3.2. Caracterización

Las técnicas realizadas en esta sección pueden dividirse en tres apartados. Análisis térmico (sección 3.2.1), que permite optimizar las condiciones de síntesis, análisis estructural, morfológico y de composición (sección 3.2.2), que permite comprobar la presencia de la fase que se busca y estudiar la forma física de las muestras sintetizadas y, finalmente, análisis óptico, magnético y eléctrico (sección 3.2.3), con el fin de relacionar estas propiedades con las estudiadas en la sección anterior. En conjunto, estos análisis permiten una caracterización apropiada de las muestras obtenidas en función del tamaño de partícula.

3.2.1. Análisis Térmico

3.2.1.1. Análisis Termogravimétrico

3.2.2. Análisis Estructural, Morfológico y de Composición

3.2.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido

Se estudió la morfología de las partículas sintetizadas a través de esta técnica, dando como resultado imágenes como las que se muestran en la figura

Inicialmente se comparó sólo el tamaño de partícula según el tamaño de calcinación, lo cual, como se muestra en la figura 3.3, no dió como resultado una relación clara. A raíz de ésto, se prepararon muestras sonicadas a partir de las calcinadas a más baja temperatura para cada tierra rara.

En general, se observa que estas partículas presentan una estructura porosa, la cual se rompe después de ser sometida a un proceso de sonicación, siendo esto evidente al comparar las figuras 3.2 (a) y 3.2 (b), las cuales muestran a las ortoferritas de NdFeO_3 calcinada a 600°C y SmFeO_3 calcinada a 700°C respectivamente, con las figuras 3.2 (c) y 3.2 (d), en donde se muestran éstas mismas muestras después de ser sonicadas por 2 horas a 292W, además de las figuras 3.2 (e) y 3.2 (f), donde éstas muestras fueron sonicadas por 4 horas a la misma potencia.

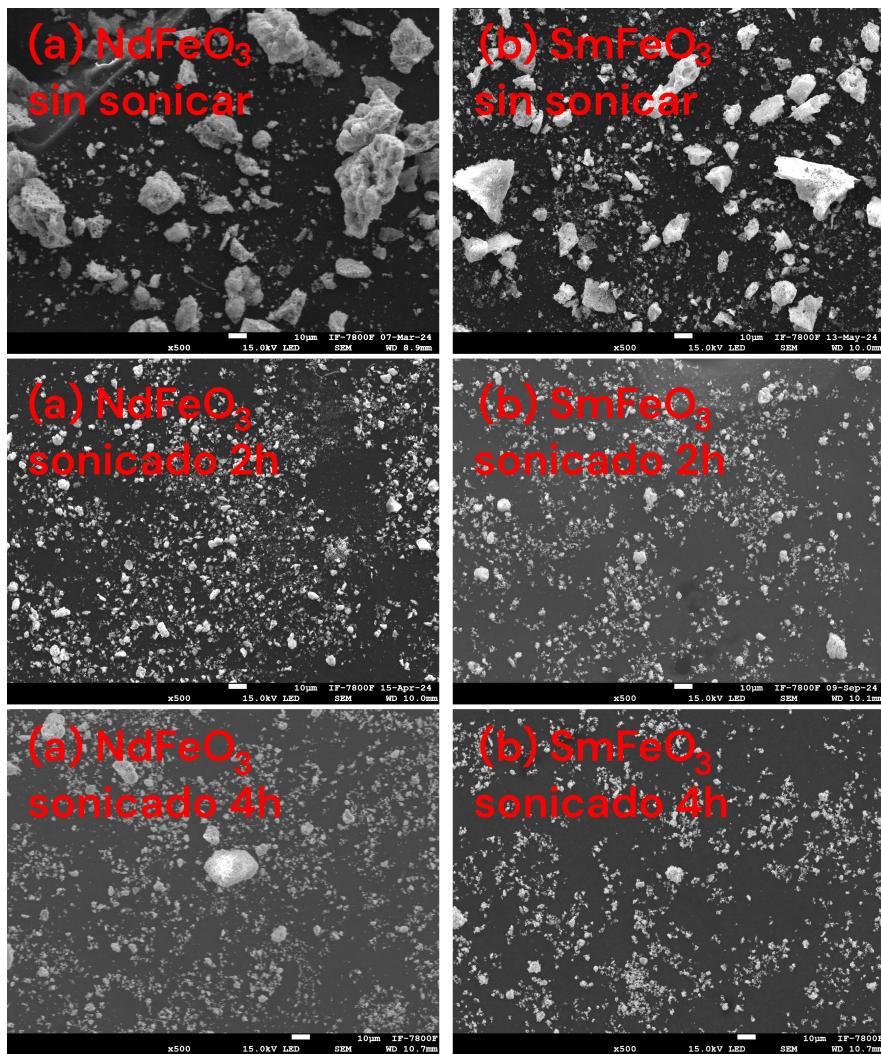


Figura 3.2: Imágenes obtenidas a través de SEM. Amplificación x500.

Como ya se describió en el capítulo 2.2.3.2, los tamaños de partícula fueron obtenidos haciendo uso de *ImageJ*, dando como resultado los histogramas presentados en la figura Finalmente, a través de los datos obtenidos, se siguió el método ya descrito en la sección 2.2.3.2, lo cual dió como resultado los siguientes datos.

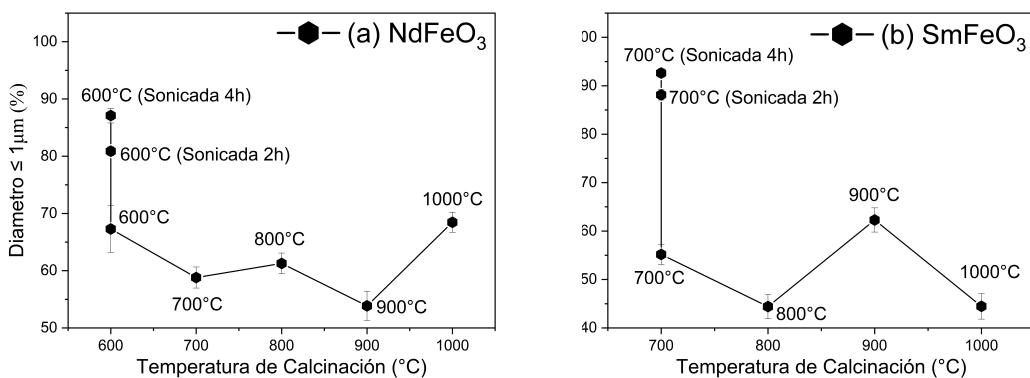


Figura 3.3: Tamaño de partícula según su temperatura de calcinación.

3.2.2.2. Espectroscopía de Dispersión de Energía

Esta técnica reveló los elementos presentes en las muestras introducidas al microscopio electrónico de barrido, lo cual permite hallar posibles contaminantes, además de delimitar las posibles estructuras cristalinas a tomar en cuenta en el análisis de la difracción de rayos X de la sección 3.2.3.

En ninguna de las mediciones se encontraron contaminantes externos, a excepción de carbono, el cuál puede explicarse debido a que la cinta utilizada para la preparación de muestras está hecha de este material, esto se reporta en las tablas 3.1 y 3.2.

Elem.	600°C Son. 2h wt %	600°C Son. 4h wt %	600°C wt %	700°C wt %	800°C wt %	900°C wt %	1000°C wt %
Fe	20.33±0.78	21.00 ± 0.77	19.94±0.68	22.23±1.01	20.31±0.67	21.0±1.04	18.37±2.06
Nd	47.88±0.92	58.44 ± 0.87	50.45±0.85	58.93±1.21	56.47±0.83	44.7±1.18	78.72±2.12
O	31.79±0.70	20.56 ± 0.56	21.71±0.54	11.04±0.57	15.06±0.45	20.4±0.57	2.92±0.60
C	0	0	7.91±0.64	7.8±0.82	8.16±0.56	13.4±0.67	0

Tabla 3.1: EDS de las muestras de NdFeO₃.

Elem.	700°C Son. 2h wt %	700°C Son. 4h wt %	700°C wt %	800°C wt %	900°C wt %	1000°C wt %
Fe	13.78 ± 0.52	19.48 ± 1.48	7.51±0.42	22.31±0.93	22.51±3.03	17.44±0.83
Sm	38.42 ± 0.74	48.22 ± 1.95	21.84±0.69	61.28±1.03	63.03±3.57	57.71±1.82
O	18.74 ± 0.45	15.64 ± 1.00	15.95±0.47	16.41±0.58	14.46±1.78	20.81±0.78
C	29.16 ± 0.62	16.66 ± 1.53	0	54.68±0.77	0	4.13±2.17

Tabla 3.2: EDS de las muestras de SmFeO₃.

3.2.2.3. Difracción de Rayos X

3.2.3. Análisis Óptico, Magnético y Eléctrico

3.2.3.1. Espectroscopía UV-Vis

3.2.3.2. Magnetometría VSM

3.2.3.2.1 M vs T

3.2.3.2.2 χ vs T

3.2.3.2.3 M v H

3.2.3.3. Espectroscopía de Impedancia

Bibliografía

- [1] Wang, Z. Q.; Lan, Y. S.; Zeng, Z. Y.; Chen, X. R. y Chen, Q. F. Magnetic structures and optical properties of rare-earth orthoferrites RFeO₃ (R = Ho, Er, Tm and Lu). *Solid State Communications* **2019**, *288*, 10-17.
- [2] Sharma, S. y Khan, S. Tailoring the structural, optical, electrical and multiferroic properties of Sm_{1-x}R_xFeO₃ (x = 0.0 and 0.5; R = Pr, Nd, and Gd) and their synergistic photocatalytic activity. *Ceramics International* **2024**, *50*, 9185-9205.
- [3] Quiñonero, J.; Pastor, F. J.; Orts, J. M. y Gómez, R. Photoelectrochemical Behavior and Computational Insights for Pristine and Doped NdFeO₃ Thin-Film Photocathodes. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2021**, *13*, 14150-14159.
- [4] Griffiths, D. J., *Introduction to electrodynamics*; Cambridge University Press: 2023, págs. 255-258.
- [5] Damjanovic, D. Hysteresis in Piezoelectric and Ferroelectric Materials. *The Science of Hysteresis* **2006**, *3-3*, 337-465.
- [6] Visintin, A. en *The Science of Hysteresis*; Elsevier: 2006, págs. 1-123.
- [7] Coey, J. M., *Magnetism and magnetic materials*; Cambridge University Press: 2010.
- [8] Qsonica, L., *Sonicator ULTRASONIC PROCESSOR Part No. Q500 OPERATION MANUAL*, Rev. 4-16, págs. 7-8.
- [9] UH-650W Ultrasonic cell crusher (Instructions).
- [10] Measurlabs Thermogravimetric analysis <https://measurlabs.com/methods/thermogravimetric-analysis-tga/>.
- [11] Garcia-Herrera, L. F. Thermogravimetric analysis (TGA) [https://chem.libretexts.org/Courses/Franklin_and_Marshall_College/Introduction_to_Materials_Characterization__CHM_412_Collaborative_Text/Thermal_Analysis/THERMOGRAVIMETRIC_analysis_\(TGA\)](https://chem.libretexts.org/Courses/Franklin_and_Marshall_College/Introduction_to_Materials_Characterization__CHM_412_Collaborative_Text/Thermal_Analysis/THERMOGRAVIMETRIC_analysis_(TGA).).
- [12] Dutrow, B. y Clark, C. X-ray Powder Diffraction (XRD), https://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRD.html.
- [13] Jung, H.; Jeong, S.; Park, Y.; Shin, Y. y Jeong, H. X-ray Diffraction Analysis of Damaged Layer During Polishing of Silicon Carbide. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* **2023**, *24*, 25-32.
- [14] Ashcroft, N. W. y Mermin, N. D., *Solid State Physics*; Harcourt College Publishers: 1976, págs. 64-68.
- [15] ScienceFacts Bravais Lattice: Definition, Types, and Structure, <https://www.sciencefacts.net/bravais-lattice.html>, 2024.

- [16] Cullity, B. D. y Stock, S. R., *Elements of X-Ray Diffraction*, 3.^a ed.; Pearson: 2014.
- [17] García, L. R., *Introducción al Método Rietveld*; Centro de Investigación en Energía: 2007.
- [18] Fuentes, L., *Introducción al Método de Rietveld*, 3.^a ed.; Sociedad Mexicana de Cristalografía, A. C.: 2004, págs. 97-104.
- [19] Lutterotti, L. MAUD - Material Analysis Using Diffraction, 2024.
- [20] Day, N. Crystallography Open Database, <http://www.crystallography.net/cod/>.
- [21] Egerton, R. F., *Physical principles of electron microscopy: An introduction to TEM, SEM, and AEM*; Springer US: 2005.
- [22] Jensen, W. Interpreting Images from Scanning Electron Microscopy - Deringer Ney, <https://deringerney.com/interpreting-images-from-scanning-electron-microscopy/>, 2022.
- [23] Rasband, W. S. ImageJ, 2018.
- [24] Stephenson, D. Example 2: Binomial distribution, <https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/dbs202/cat/courses/MT37C/course/node43.html>, 2005.
- [25] Oda, B., *Introducción al Análisis Gráfico de Datos Experimentales*, 3.^a ed.; UNAM, Facultad de Ciencias: 2017.
- [26] Tom, J. UV-Vis Spectroscopy: Principle, Strengths and Limitations and Applications. *Analysis & Separations* **2023**, <https://www.technologynetworks.com/analysis/articles/uv-vis-spectroscopy-principle-strengths-and-limitations-and-applications-349865>.
- [27] Büyükkö, O. Manufacturing and characterization of perovskite thin films using novel methods. **2020**.
- [28] Makuła, P.; Pacia, M. y Macyk, W. How To Correctly Determine the Band Gap Energy of Modified Semiconductor Photocatalysts Based on UV-Vis Spectra. *Journal of Physical Chemistry Letters* **2018**, *9*, 6814-6817.
- [29] MicroNanoTools Bench-top High Speed Vibrating Ball Mill with Speed Control (HVBM-1200V) Incl. one 80ml SS Jar - 2-year Warranty, <https://www.micronanotools.com/products/copy-of-bench-top-high-speed-vibrating-ball-mill-hvbm-1200v-with-one-80ml-ss-jar-2-year-warranty>.
- [30] Baheti, V.; Abbasi, R. y Militky, J. Ball milling of jute fibre wastes to prepare nano-cellulose. *World Journal of Engineering* **2012**, *9*, 45-50.
- [31] Banerjee, S. y Joens, C. J. Debinding and sintering of metal injection molding (MIM) components. *Handbook of Metal Injection Molding* **2019**, 129-171.
- [32] Ou, H.; Sahli, M.; Gelin, J. C. y Barrière, T. Experimental analysis and finite element simulation of the co-sintering of bi-material components. *Powder Technology* **2014**, *268*, 269-278.
- [33] Room temperature dual ferroic behaviour of ball mill synthesized NdFeO₃ orthoferrite. *Journal of Applied Physics* **2016**, *120*, 34101.
- [34] Stewart, M. y Cain, M. G. Ferroelectric Hysteresis Measurement & Analysis. *NPL Report* **1999**.